



## 19 日本国特許庁

# 公開特許公報

寺 新 願(/)後記がなし

昭和49年3月22日

特許庁長官 殿

1 発射の名称 がわ が ジャン ひかい が が かだエボキン かいかの かま

①特開昭 50-125000

43公開日 昭 50. (1975) 10.1

②特願昭 49-32940

22出願日 昭49 (1974) 3.22

審査請求 未請求

(全 3頁)

庁内整理番号 93// 45 9/33~45

265K211 · 1 265E131 · 1 (1) Int.C1? (1) COSO 59/42 (1) COSO 73/10

2 差 明 者 任 新

大阪府門東市大学門東1048番地 松下 電工 株式 会 社 内

氏 名 特許出顧人

公村 点 並 (元か2名)
大阪府門真市大学門以1048番地

(583) 松下電工株式会社 丹 羽 正 抬

代 <sup>理</sup> 人 、 住 所

大阪府門真市大字門寅1048番地 松下電工株式会社特許課内 (6201) 弁理士 竹 元 敏 丸

5 松付書類の目録 (1) 明 編 (2) 図



### 明 細 書

L 発明の名称 耐熱性エポキシ樹脂の製法

2. 特許請求の範囲

「配一般式(1)で表わされるエポキシ化合物と、「配一般式(1)で表わされるベンツイミダソール後を含むジカルボン酸を反応させることを特徴とする対為性エポキン歯腸の製法。

(ここで四紋:, 2 , 3 )

( C C T X 11 0 . 8 , 80; , CH2 )

B. 発謝の詳細な説明

本発明は耐熱性の改良されたエポキシ樹脂の要

法に関するものである。

使来、エポキシ戦闘の耐熱性を向上させる目的で種々の試みがなされているが、代表的な試みとしては、ビス〔もー(1ーメチルー L 2 ーエポキシエチル)フェニル〕エーテル等とピロメリット破またはトリメリット鍛などの芳香版ポリカルボン戦からエポキシ衛嗣を得る方法が知られている本発明はこのエポキシ衛嗣とりもさらに耐然性の改良された斬殺なエポキシ衛嗣の製法を提供するものである。

すなわち、本発明は下配一般式[1]で表わされるエポキシ化合物と、下配一般式[1]で表わされるペンツイミダゾール複を含むジカルボン酸を反応させることを整備とする。

(CCTMH1, 2, 8)

$$HOOC - \bigcirc - C \xrightarrow{N} \bigcirc - X - \bigcirc \xrightarrow{N} C - \bigcirc - COOH$$

( ここで×110 . 8 , 802 , CH2 )

上記 エポキン化合物としてはヒス(4ー(1ーメチルー L 2 ー エポキンエチル)フェニル )エーテル、ハイドロギノンピス(4ー(1-メチルー L 2 ー エポキシエチル)フェニル 〕エーテル、 4 4 ー ジオキンジフェニルエーテルー 4 4 ー ビス(4ー(1-メチルー L 2 ー エポキシエチル)フェニル 〕エーテル左どがある。これらエポキン化合物の合成はは Juurnul of Applied Polymer Science 第11 巻(1967 年)、2029 頁~2036 頁に示されている。

またペンツイミダゾール核を含むジカルボン酸の合成法は上記一般式[i]中のXがOの化合物については、たとえば以下の反応式にもとづいて合成される。

ノシフェニルエーテルは、下配に示す反応式にもとずいてジアミノジフェニルエーテルをアセチル化し、 穴に磷硝酸でニトロ化した後加水分解しさらに pd - C 強媒を用いて水業磁化して容易 に得られる。

$$H_N \longrightarrow O \longrightarrow NH_2 \xrightarrow{2CH_2COC\ell} CH_2 \xrightarrow{0} H \longrightarrow O \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \xrightarrow{0} H \longrightarrow O \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \xrightarrow{0} H \longrightarrow O \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \xrightarrow{0} H \longrightarrow O \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \xrightarrow{0} H \longrightarrow O \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \xrightarrow{0} H \longrightarrow O \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \longrightarrow CH_2$$

以上の後にして後られるペンツイミダゾール複 を含むカルボン酸と前記のエボキン化合物を配合 し、反応させることにより極めて高い耐熱性を有 する酸化物を得ることができる。配合比はカルボ

または、

すなわちる 3°、 4、 5°、 一テトラアミノジフエニルエーテルにイソフタル酸またはテレフタル酸の少くとも 1 減を化学反応当歳以上で反応させるか、または、トルイル酸を化学反応当盤以上で反応させた後酢酸を溶媒として、産クロム酸カリウムと濃硫酸の水溶液で酸化して合成される。 なお上記反応に用いる 3 8°, 4、 6° ーテトラアミ

キシル基化対し化学反応当量以上のエポキシ基を含有式る限り限定する必要はないが、好ましくは -COOH/CH, - C- の比で 2 5 - L 0 がよい。

エボキシ化合物とベンツイミダゾール核を含むシカルボン線の配合物は、両者を反応させて硬化させる前は熱時、加圧化より流動性を示し、破形性を行することから適当な充填材、補強材を混合するか、または混合せずに改形材料として明いることができる。またガラス布などを基材として明いてプリプレグを得て発法により機関板を得ることもできる。

なか、芯材としては常弦化よるエポキン樹脂ーカラスマットプリアレグを用い、表層中としてさきの配合物を用いたプリアレグを用いて設層収形し安価で耐燃性等の良い複合機関板を得ることもできるし、さら化成形作楽して網箔などの金銭箔を一体化させ、プリント配線器板とすることもできる。

以下夹腕的に基づき説明する。

更 旅 渕

( ベンツイミダゾール核を含むジカルボン酸の合 、

105%のポリリン酸5001中代120~ 180℃の温度でイソフタル酸1.889(011 モル)を役入して十分機拌した後38′、8分′一 テトラアミノジフエニルエーテル 1 L 5 g ( Q.05 モル)を徐々に盛加した。つぎに多時間かけて徐 々に加熱し、上記俗液が190cに速した時から 8 時期飛祥反応させた後、2 4 の氷水中に投入し て沈浚物を得た。との沈澱物を破圆罐選、水洗し さらに無偏で洗浄をくりかえして上記沈破物から 不確初の徐太された粉状の皮応生成物を得た。こ の反応生成物は、ジメチルアセトアミド、及びN ーメチルピロリドン等の値性溶媒に可容であった なむ、赤外嵌吸収スペクトルの分析結果、 1700~ 1680 🛩 化カルホキシル基化基因する吸収が現 われ、かつ 1620 四 付近にイミダゾール核に 起 凶する吸収が現われ、また上記力点ボキシル基の

が消滅したことからカルボキシル基とエボキシ基の反応によって生成したものと確認された。この域化切の示差磁分析の結果、320でまで重重変化がなく、磁分解反応はみとめられなかったので 解無性が良好であった。

特許出顧人

松 下 電 工 株 式 会 社 代理人弁理士 竹 元 敏 丸 ( 15 か 2 名 ) 特別 昭50 125000(3) 定生側定により、反応生成物は、前記一般式 I で示す X が破業で置換されたベンツイミダゾール核を含むジカルボン酸であることが確認できた。 なお、上記反応生成物は、イソフタル酸がメタノールに可容性を貸しているのに対し全く不容であることから上記反応生成物中には、イソフタル酸は残存していないと判断され、したがって上記1700~1680 cm<sup>-1</sup> の 吸収は反応生成物の結合 にあずかるカルボキシル基であると認められた。

(耐品性エポキシ樹脂の製造)

さきに得たベンツイミダゾール核を含むジカルボン級5 g とピス ( 4 ー ( 1 ーメチルー 1.2 ー エポキシエチル ) フェニル ) エーテル 5 g を霧留したジメチルアセトアミドの福小盆に容解混合した後、120 でで2時間、150 でで30分間、180 でで30分間、200 でで1時間処理しさらに230 でで1 4 時間処理し暗褐色の硬化物が得られた。この硬化物は、ジメチルアセトアミドに溶解せず、又赤外線吸収スペクトル分析の結果、カルボキシル基に起因する1700~1890cmでの吸収

#### 6 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1) 発 明 者
任 所 大阪府門與市大字門真1048番地 松下 龍 立 株式 会 社 内

氏 名 博 山 華 久

住 所 阿 所
氏 名 野 口 民 治

#### (2) 特許出願人